

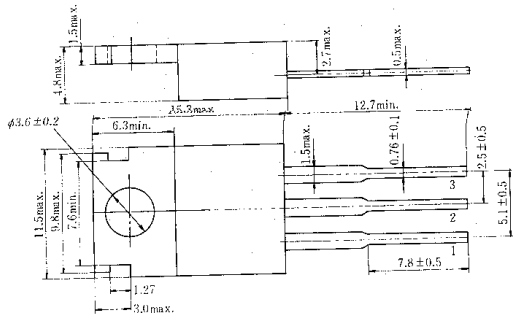
2SC1723

シリコン NPN 三重拡散 LTP 形

低周波高電圧電力増幅用
TV 電源励振用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED LTP

LOW FREQUENCY HIGH VOLTAGE POWER
AMPLIFIER
TV POWER SUPPLY DRIVER



1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
(フランジ) (Flange)
 3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

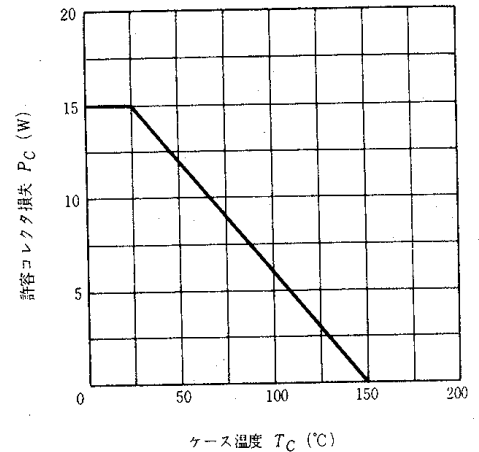
(JEDEC TO-220AB)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SC1723	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	300	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	300	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	0.2	A
許容コレクタ損失	P_C^*	15	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値
* Value at $T_C=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE

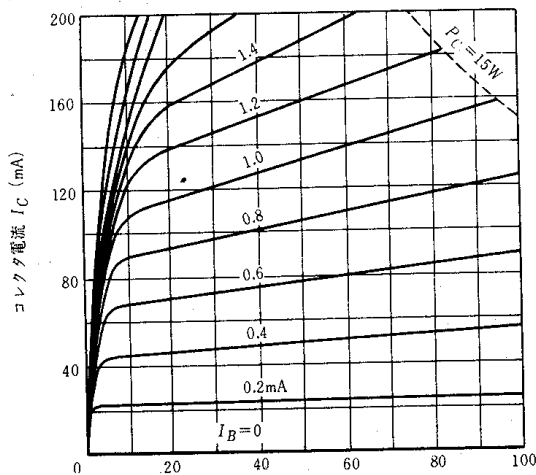


■ 電氣的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=5\text{mA}, R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=250\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	2	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	40	—	200	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	0.32	1.5	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	—	0.66	0.9	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=30\text{mA}$	—	60	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=50\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	6.2	8	pF

エミッタ接地出力静特性

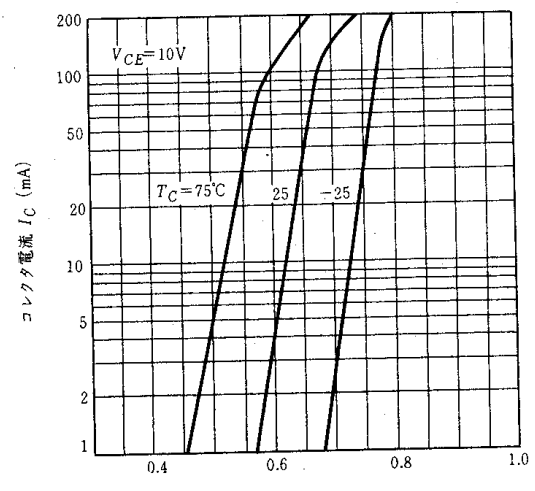
TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS



コレクタ・エミッタ電圧 V_{CE} (V)

エミッタ接地伝達静特性

TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS



ベース・エミッタ電圧 V_{BE} (V)